

## 製品概要

### SI3457DV: シングルPチャンネル ロジックレベル PowerTrench® MOSFET

技術情報は、データシートをご参照ください。

このPチャンネルMOSFETは、フェアチャイルドの高度なPowerTrenchプロセスを使用して製造されます。バッテリーパワーマネージメント用途に最適化されています。

### 特長

- -4 A, -30 V。
- $R_{DS(ON)} = 50 \text{ m}\Omega$  @  $V_{GS} = -10 \text{ V}$
- $R_{DS(ON)} = 75 \text{ m}\Omega$  @  $V_{GS} = -4.5 \text{ V}$  少量のゲート電荷
- 特に低い $R_{DS(ON)}$ 用の高性能トレン
- High performance trench technology for extremely low  $R_{DS(ON)}$

### アプリケーション

- This product is general usage and suitable for many different applications.

### 電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS(sat)}$ Min (V)	$V_{GS}$ Max (V)	$V_{GS(th)}$ Max (V)	$I_D$ Max (A)	$P_D$ Max (W)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5 \text{ V}$ (m $\Omega$ )	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ (m $\Omega$ )	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ (m $\Omega$ )	$Q_g$ Typ @ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ (nC)	$Q_g$ Typ @ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ (nC)	$C_{iss}$ Typ (pF)	Package Type
SI3457DV	0.3388	Pb-free Halide free	Active	P-Channel	Single	-30	25	-3	-4	1.6	-	75	50	-	6	470	TSO T-23-6

詳細は、弊社 [www.onsemi.jp](http://www.onsemi.jp) の営業または販売代理店にお問い合わせください。

5/31/2020 作成